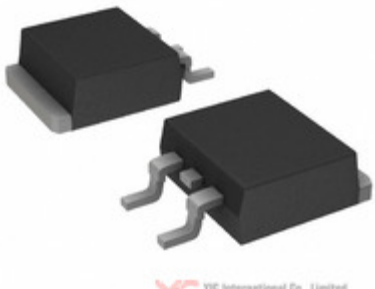

	<h2 style="color: red;">FDB24AN06LA0</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FDB24AN06LA0
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 40A TO-263AB
	Datenblätter:  FDB24AN06LA0.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 28650 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	








Spezifikationen

Teilenummer	FDB24AN06LA0
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 40A TO-263AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	28650 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	19 mOhm @ 40A, 10V
Verlustleistung (max)	75W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1850pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	21nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 7.8A (Ta), 40A (Tc) 75W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.8A (Ta), 40A (Tc)

FDB24AN06LA0 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB24AN06LA0-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB24AN06LA0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDB24AN06LA0 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

 <p>FDB20AN06AO AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 45A TO-263AB</p>	 <p>FDB20N50F Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 20A D2PAK</p>	 <p>FDB20N50F AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 20A D2PAK</p>	 <p>FDB2532-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 79A D2PAK</p>
 <p>FDB2532 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 79A D2PAK</p>	 <p>FDB20AN06AO FSC FDB20AN06AO FSC</p>	 <p>FDB2532 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 79A D2PAK</p>	 <p>FDB2532(FDI2532) FAIRCHI FDB2532(FDI2532) FAIRCHI</p>

FDB24AN06LA0 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDB24AN06LA0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB24AN06LA0 Datenblatt	FDB24AN06LA0-Datenblätter	FDB24AN06LA0 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB24AN06LA0
FDB24AN06LA0 Electronic	FDB24AN06LA0-Komponenten	FDB24AN06LA0-Verteiler	FDB24AN06LA0-Bild	FDB24AN06LA0-Teil
FDB24AN06LA0 Preis	FDB24AN06LA0 Hersteller	FDB24AN06LA0 Bild	FDB24AN06LA0 Aktie	FDB24AN06LA0 Inventar
FDB24AN06LA0 Neu	FDB24AN06LA0 Original	FDB24AN06LA0 garantiert	FDB24AN06LA0 RFQ	FDB24AN06LA0 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited